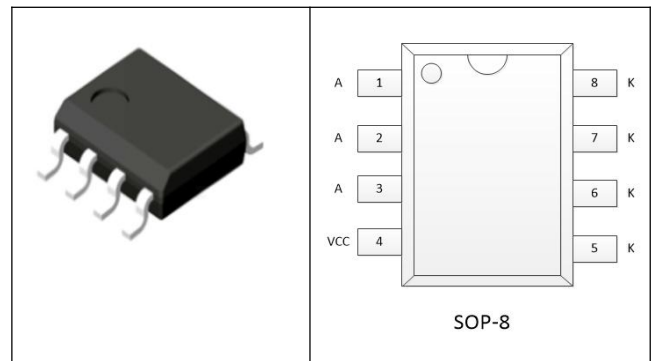


DK5V45R25P 一 单 同
 。 内 了45V功 NMOS ，可以
 低二 ， ，取代
 前 上 二 。

DK5V45R25P SOP-8 。

- USB 充 器
- 器
- LED 动

- 于反 PSR
- 低 V_f
- 低 升
- 45V 25mΩ功 NMOS
- 可 作于 DCM、QR
- ， 前 同 信号
- EMI/C 善
- 可以 二
- 任何



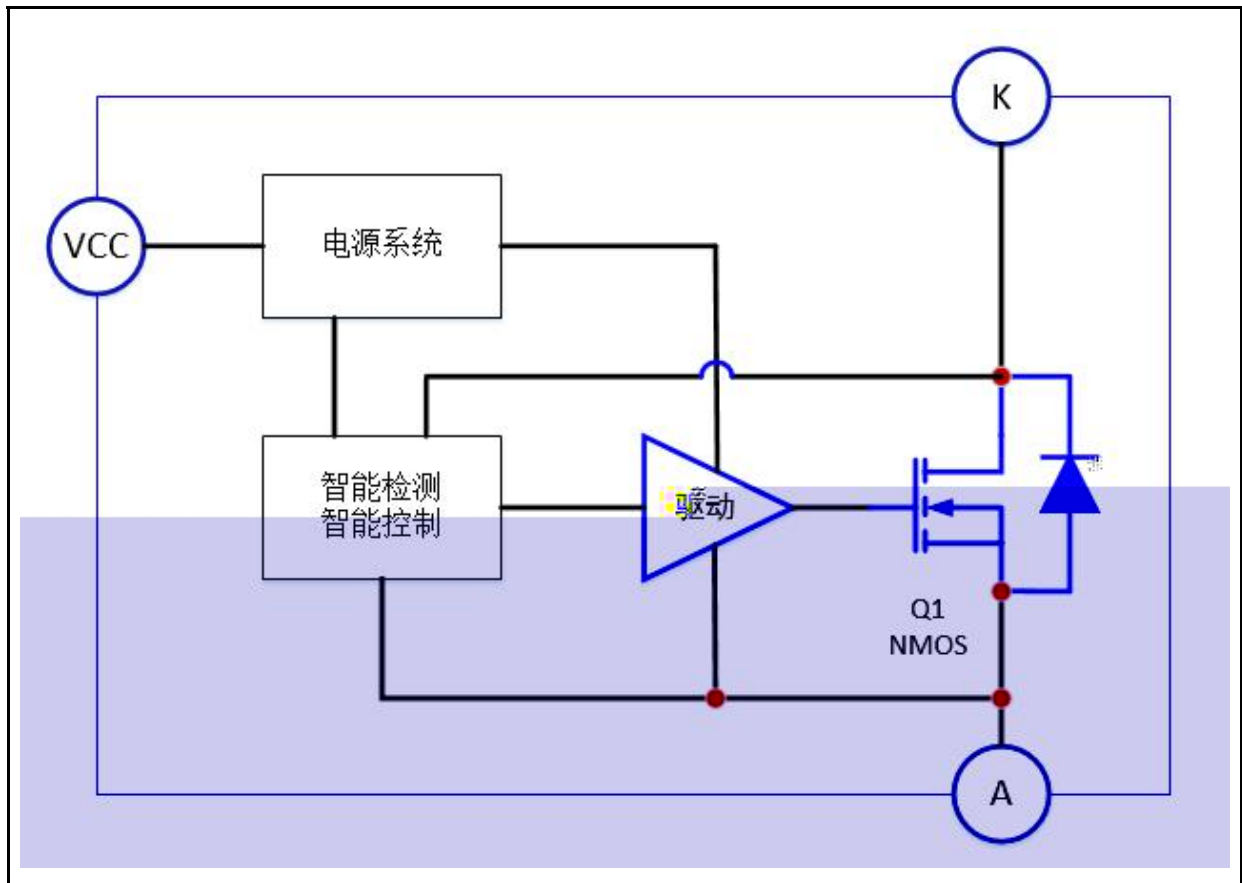
号	名	
1,2,3	A	同二
4	VCC	供 。
5,6,7,8	K	同二

产品号	入压	典功
DK5V45R25P	85-265VAC	5V, 2.1A

45

, DK5V45R25P

2.1A.



参	号	值	典 值	值	单 位
NMOS 压	$V_{(BR)DSS}$	45			V
NMOS ①	I_{DSCDC}			30	A
NMOS 值	I_{DSPDC}			40	A
SOP8 功	P_{DMAX}		1		W
	$R\theta$		7		

DK5V45R25P 一 单 三个 同 ， 5V 低 VCC 出 ， 任何 器件，可以 低传 二 ， 。

1.

。 5V 低 ， 出 压低于启动 压 V_{cc_on} ， 内 功 MOS 关 ， 依 体二 。 V_{cc} 压 于 V_{cc_on} ， 启动 。 V_{cc} 压 低到 位 压 V_{cc_off} 以下 ， 入启动 。

2. NMOS

到 A、K 向 压 于 压 V_{on} ， 则 功 MOS ； 到 功 MOS 减 到 0 ， 即 A、K 向 压为 ， 则关 功 MOS 。

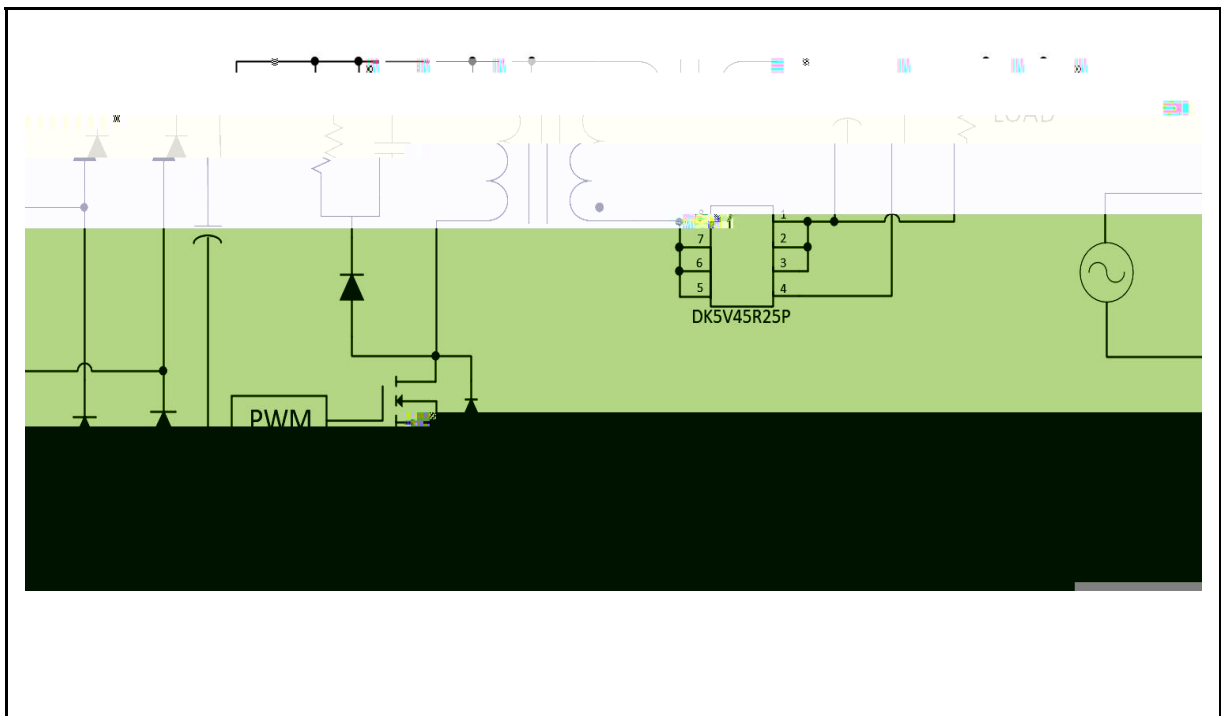
3. RC

启动、出 、 入 压 ,CCM 二 体产 压,为 内 NMOS 压击 ， 可以 A 和 K 之 入 RC 吸 ， 以减 N 压。

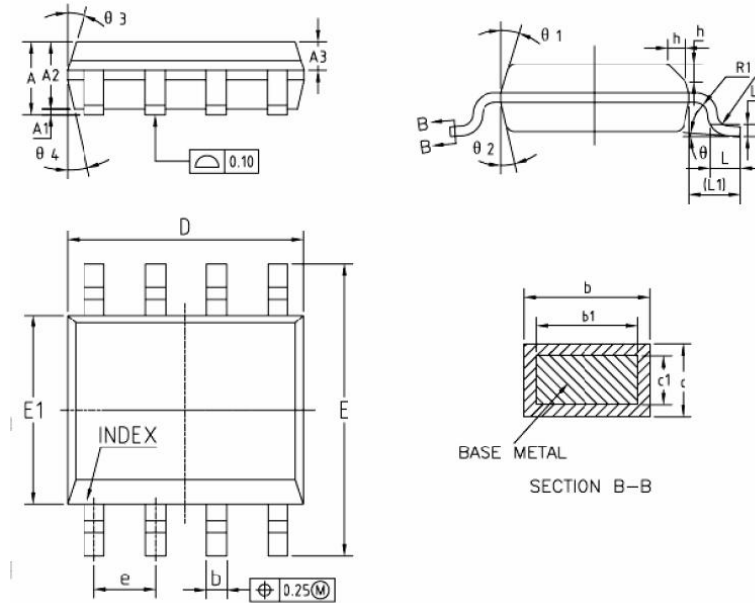
4. NMOS

于 NMOS 。 作 中， 升 ， 内 值会 ， 会 低。 可 加 ， 低 IC 作 。

Low Side

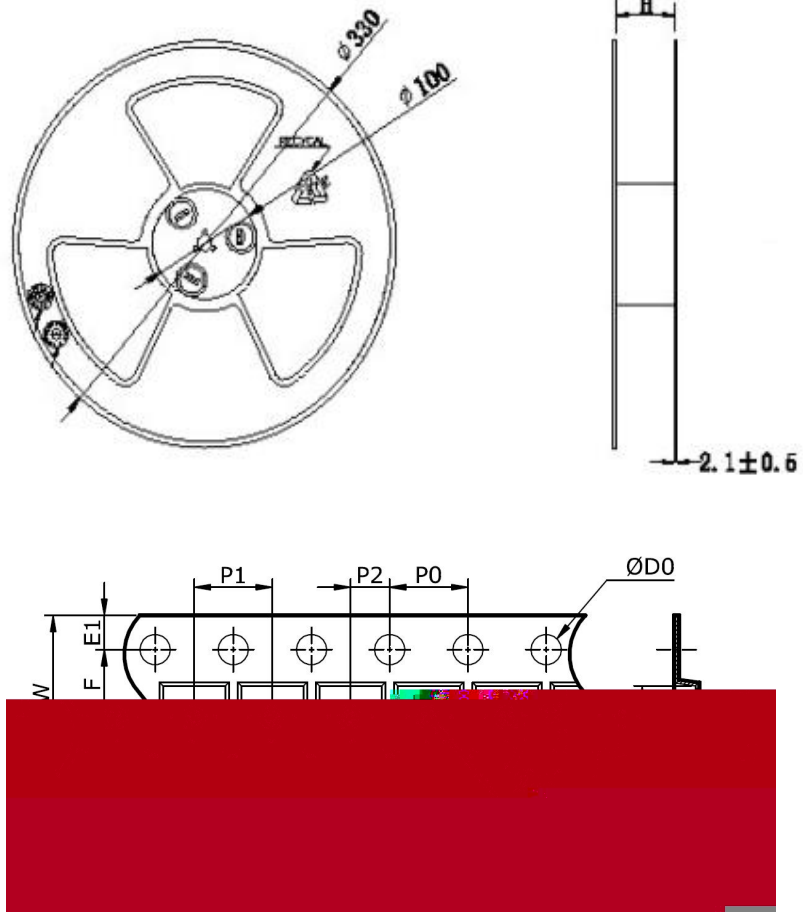


SOP-8

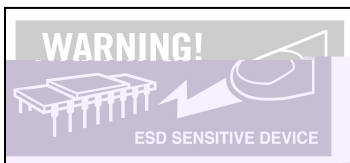


Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max
A	1.35	1.75
A1	0.10	0.25
A2	1.25	1.65
A3	0.50	0.70
b	0.38	0.51
b1	0.37	0.47
c	0.17	0.25
c1	0.17	0.23
D	4.70	5.10
E	5.80	6.20
E1	3.80	4.00
L	0.45	0.80
L1	1.04REF	
L2	0.25BSC	
e	1.270(BSC)	
θ	0°	8°

2. 4K/



SOP-8 Package					
A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	W (mm)	F (mm)	E1 (mm)
6.60±0.1	5.2±0.1	1.9±0.1	12.00±0.1	5.50±0.1	1.75±0.1
P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	$\phi D0$ (mm)	$\phi OD1$ (mm)	
4.00±0.1	8.0±0.1	2.0±0.1	1.5±0.1	1.55±0.05	

 <p>WARNING! ESD SENSITIVE DEVICE</p>	<p>： 产品为 元件， ! ESD 可以 从 下 到 。 可 受到 , 可 元件参 不 公 。</p>
---	--

- 使 公司 产品, 使 前仔 。
- 东 半 体 公司保 利, 不另 。
- 东 半 体 公司 任何 其产品 于 为不 任何 任。
- 东 半 体 公司 为 于 产品 供使 和 义务。
- 东 半 体 公司不会 其专利 可以及任何其他 关 可 利。
- 任何半 体产品 件下 一 发 可, 买 任 使 东 半 体 公司
产品 和 制 全 准 取 全, 以 免 可 人 伤 产
况 发 !
- 产品 升 , 公司 为 供 优 产品